

Сведения об официальном оппоненте
 по диссертационной работе **Шутаева Вадима Аркадьевича**
 на тему «**Создание и исследование сенсора водорода на основе диодной
 структуры Pd/оксид/InP**»,
 представленной на соискание ученой степени
 кандидата физико-математических наук
 по специальности 01.04.10 – физика полупроводников

Фамилия	Мынбаев
Имя	Карим
Отчество	Джафарович
Гражданство	РФ
Ученая степень	Доктор физико-математических наук
Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация (для докторов наук – на соискание ученой степени доктора наук)	01.04.10 – Физика полупроводников
Место работы (полное название организации)	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
Должность	Заведующий лабораторией, главный научный сотрудник
Структурное подразделение	Лаборатория фотоэлектрических явлений в полупроводниках
Адрес организации	194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
Телефон рабочий	292-71-82
E-mail:	mynkad@mail.ioffe.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мынбаев К.Д.; Баженов Н.Л.; Смирнов А.М.; Михайлов Н.Н.; Ремесник В.Г.; Якушев М.В. Оптические и структурные свойства твердых растворов HgCdTe с большим содержанием CdTe 2020 ФТП, т.54, 12, страницы: 1302-1308. 2. Семакова А.А.; Липницкая С.Н.; Мынбаев К.Д.; Баженов Н.Л.; Кижаяев С.С.; Черняев А.В.; Стоянов Н.Д.; Lipsanen H. Экспериментальное исследование и моделирование спектральных характеристик светодиодных

гетероструктур с активной областью из InAs. 2020 Письма ЖТФ, т.46, 3, страницы: 51-54.

3. Баженов Н.Л.; Мынбаев К.Д.; Семакова А.А.; Зегря Г.Г. Время жизни неравновесных носителей заряда в полупроводниках с близкими значениями запрещенной зоны и спин-орбитального отщепления, 2019 ФТП, т.53, 4, страницы: 450-455.
4. Определение параметров латерального и нестационарного шнуrowого токов в цилиндрическом халькогенидном стеклообразном полупроводнике. Совтус Н.В.; Мынбаев К.Д. 2019, ФТП, т.53, 12, страницы: 1669-1673.
5. Исследование разупорядочения в твердых растворах теллуридов кадмия-ртути оптическими методами. Иванов-Омский В.И.; Мынбаев К.Д.; Трапезникова И.Н.; Андрющенко Д.А.; Баженов Н.Л.; Михайлов Н.Н.; Варавин В.С.; Ремесник В.Г.; Дворецкий С.А.; Якушев М.В. 2019, Письма ЖТФ, т.45, 11 страницы: 24-27.
6. Исследование возможностей метода газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений для изготовления тонких слоев InAs/GaSb. Левин Р.В.; Пушный Б.В.; Федоров И.В.; Усикова, А.А.; Неведомский В.Н.; Баженов Н.Л.; Мынбаев К.Д.; Павлов Н.В.; Зегря Г.Г. 2019, ЖТФ, т.89, 10 страницы: 1592-1697
7. Влияние флуктуаций состава на излучательную рекомбинацию в узкозонных полупроводниковых твердых растворах. Шилиев А.В.; Мынбаев К.Д.; Баженов Н.Л.;

Грешнов А.А.
2017, ЖТФ, т.87, 3 страницы: 419-426.

8. Электролюминесценция светодиодных гетероструктур InAs/InAs(Sb)/InAsSbP в диапазоне температур 4.2-300 К. Мынбаев К.Д.; Баженов Н.Л.; Семакова А.А.; Михайлова М.П.; Стоянов Н.Д.; Кижаяев С.С.; Молчанов С.С.; Астахова А.П.; Черняев А.В.; Lipsanen H; Бугров В.Е. 2017, ФТП, т.51, 2 страницы: 247-252.
9. Дефекты в гетероэпитаксиальных структурах теллуридов кадмия и ртути, выращенных молекулярно-лучевой эпитаксией на подложках из кремния. Мынбаев К.Д.; Заблоцкий С.В.; Шиляев А.В.; Баженов Н.Л.; Якушев М.В.; Марин Д.В.; Варавин В.С.; Дворецкий С.А. 2016, ФТП, т.50, 2 страницы: 208-211.
10. Формирование структур графит/SiC методом термического разложения карбида кремния. Мынбаева М.Г.; Лаврентьев А.А.; Мынбаев К.Д. 2016, ФТП, т.50, 1 страницы: 138-142.